

# Поверхностные волны на границе фоторефрактивного кристалла и среды с положительной керровской нелинейностью

© С.Е. Савотченко

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова  
Белгород, Россия

E-mail: savotchenkose@mail.ru

Поступила в Редакцию 19 октября 2019 г.

В окончательной редакции 19 октября 2019 г.

Принята к публикации 25 октября 2019 г.

Описаны типы нелинейных поверхностных волн необыкновенной поляризации, возникающие на границе раздела фоторефрактивного кристалла и среды с положительной керровской нелинейностью. Показано, что в такой системе могут существовать нелинейные поверхностные волны несимметричного профиля двух типов. Волны первого типа затухают при удалении от границы раздела без осцилляций как в глубину фоторефрактивного кристалла, так и керровского, а волны второго типа затухают в глубину фоторефрактивного кристалла с осцилляциями. Получены дисперсионные соотношения и указаны условия существования всех описанных типов волн в зависимости от оптических характеристик кристаллов.

**Ключевые слова:** граница раздела сред, фоторефрактивный кристалл, оптическая нелинейная среда, нелинейные поверхностные волны.

DOI: 10.21883/FTT.2020.06.49345.624

## 1. Введение

Существует множество теоретических работ, посвященных описанию поверхностных электромагнитных волн (плазмонов, поляритонов) на границах различных сред [1–7]. Особое значение имеют исследования свойств поверхностных волн в различных нелинейных оптических средах, таких как фоторефрактивные кристаллы [8–11] и среды с эффектом Керра [12]. Однако особенности распространения нелинейных поверхностных волн на границах сред, в которых нелинейные эффекты обусловлены различными механизмами перераспределения плотности зарядов и индцированного ими поля, остаются мало изученными. Поэтому требуют детального анализа многие практически важные аспекты, в частности, закономерности формирования нелинейных поверхностных волн с несимметричным профилем, возникающих вблизи границ между фоторефрактивными кристаллами и другими нелинейными оптическими средами.

В большинстве существующих теоретических работ рассматривается локализация возбуждений электромагнитного поля вблизи границ раздела сред с одинаковыми по физической природе формами нелинейности (наиболее часто встречающийся случай — контакт двух сред с керровской нелинейностью [13–18]), либо на границе раздела линейной и нелинейной сред [19–22].

В настоящей работе предлагается теоретическое описание новых типов нелинейных локализованных состояний, соответствующих поверхностным волнам на границе двух оптических сред с различными по физической природе формами нелинейности: фоторефрактивно-

го кристалла и кристалла с керровской нелинейностью. Очевидно, что такие поверхностные волны будут иметь несимметричный профиль относительно границы раздела сред.

## 2. Формулировка модели

Рассмотрим контакт одноосного фоторефрактивного кристалла с диффузионным механизмом формирования нелинейности и одноосного кристалла с керровской нелинейностью (далее будем для краткости называть его керровским кристаллом) в отсутствие приложенного внешнего поля. Границу раздела кристаллов будем считать настолько тонкой, что можно будет пренебречь оптическими эффектами внутри нее.

Будем изучать Р-поляризованные нелинейные поверхностные волны, для которых  $E_y = 0$ ,  $H_x = H_z = 0$ , т.е. волны с необыкновенной поляризацией (ТМ-волны). Так как будет рассматриваться скользящее распространение светового пучка, то можно пренебречь анизотропией показателя преломления и использовать одноосное приближение.

Пусть полярная ось фоторефрактивного кристалла направлена вдоль оси  $x$ . ТМ-волна распространяется вдоль оси  $z$ . Граница раздела между фоторефрактивным и керровским кристаллами расположена в плоскости  $x = 0$ . Фоторефрактивный кристалл занимает полупространство  $x > 0$ , а керровский — полупространство  $x < 0$ .

Будем рассматривать только стационарное распределение поля поверхностной волны. Из системы уравнений Максвелла в рассматриваемом случае получается уравнение для отличной от нуля компоненты вектора

магнитного поля

$$\Delta H_y + k^2(x)H_y = 0, \quad (1)$$

где  $\Delta$  — двумерный оператор Лапласа по координатам  $x$  и  $z$ ,

$$k(x) = k_0\{n_{j0}(x) + \Delta n_j(x)\},$$

$k_0 = 2\pi/\lambda_0$ ,  $\lambda_0$  — длина волны света в вакууме,  $n_{j0}$  — невозмущенные показатели преломления,  $\Delta n_j$  — нелинейные добавки к ним, которые считаются малыми ( $\Delta n_j \ll n_{j0}$ ),  $j = 1, 2$ . Здесь и далее значение индекса  $j = 1$  соответствует величине, характеризующей фоторефрактивный кристалл в области  $x > 0$ , а значение индекса  $j = 2$  соответствует величине, характеризующей керровский кристалл в области  $x < 0$ .

Нелинейная добавка к показателю преломления фоторефрактивного кристалла формируется в результате диффузионного механизма нелинейности [23]. Если пренебречь темновой интенсивностью по сравнению с интенсивностью поверхностной волны, то нелинейную добавку к показателю преломления фоторефрактивного кристалла можно представить в виде [9,10,23]:

$$\Delta n_1(x) = \frac{1}{2} n_{10}^3 r_{eff} \frac{k_B T I_1'}{e I_1}$$

где штрихи здесь и далее означают производные по координате  $x$ ,  $r_{eff}$  — эффективный электрооптический коэффициент,  $k_B$  — константа Больцмана,  $T$  — температура,  $e$  — модуль заряда электрона,  $I_j \propto |H_j|^2$  — интенсивность светового пучка в поверхностной волне.

Нелинейная добавка к показателю преломления керровского кристалла пропорциональна интенсивности:  $\Delta n_2(x) \propto I_2$ . Для нее будем использовать выражение в виде:  $\Delta n_2(x) = \alpha |H_2|^2$ ,  $\alpha$  — коэффициент керровской нелинейности. В данной работе он считается постоянным и положительным, что соответствует керровской среде с фокусировкой.

Предполагая, что установившееся распределение поля в распространяющейся вдоль оси  $z$  волне представимо в виде

$$H_y(x, z) = H_j(x) e^{i\beta k_0 z},$$

где  $\beta$  — константа распространения, в рассматриваемом приближении с учетом малости темновой интенсивности по сравнению с интенсивностью поверхностной волны и малости невозмущенных показателей преломления по сравнению с нелинейными добавками к ним, из (1) можно получить уравнения

$$H_1'' + \mu H_1' + (n_{10}^2 - \beta^2) k_0^2 H_1 = 0, \quad (2)$$

$$H_2'' + (n_{20}^2 - \beta^2) k_0^2 H_2 + g |H_2|^2 H_2 = 0, \quad (3)$$

где обозначили  $\mu = 2k_0^2 n_{10}^4 r_{eff} k_B T / e$  — коэффициент затухания волны в фоторефрактивном кристалле,  $g = 2\alpha k_0^2 n_{20}$  — коэффициент нелинейности в керровском кристалле (в данной работе он считается положительной величиной).

Из условия непрерывности тангенциальных составляющих полей на границе кристаллов следуют граничные условия

$$H_1(0) = H_2(0) = H_0, \quad (4)$$

$$\frac{1}{\varepsilon_1} H_1'(0) = \frac{1}{\varepsilon_2} H_2'(0), \quad (5)$$

где  $H_0$  — амплитуда поля на границе раздела,  $\varepsilon_j \propto n_{j0}^2$  — линейные (невозмущенные) части диэлектрических проницаемостей фоторефрактивного и керровского кристаллов соответственно.

Таким образом, математическая формулировка модели для описания нелинейных поверхностных волн на границе фоторефрактивного и керровского кристаллов сводится к уравнениям (2) и (3) с граничными условиями (4) и (5).

### 3. Нелинейные поверхностные волны

Уравнение (2) имеет два типа исчезающих на бесконечности решений в зависимости от соотношения между значениями константы распространения, коэффициента затухания и невозмущенного показателя преломления в фоторефрактивном кристалле. Амплитуда волны первого типа затухает без осцилляций при удалении от границы раздела вглубь фоторефрактивного кристалла, а второго — осциллирующим образом [24].

Решения нелинейного уравнения (3) определяются знаком коэффициента нелинейности  $g$  и знаком разности  $n_{20}^2 - \beta^2$ . В зависимости от их комбинаций возникает несколько типов нелинейных поверхностных волн несимметричного профиля.

В настоящей работе будем рассматривать керровскую среду только с положительным коэффициентом нелинейности.

#### 3.1. Затухающие без осцилляций волны

При  $g > 0$  и  $\max\{n_{20}, \sqrt{n_{10}^2 - \mu^2/4k_0^2}\} < \beta < n_{10}$  решение уравнений (2) и (3) представимо в виде

$$H_1(x) = e^{-\mu x/2} (Ae^{\nu x} + B e^{\nu x}), \quad (6)$$

$$H_2(x) = \sqrt{\frac{2}{g}} \frac{q}{\text{ch } q(x - x_0)}. \quad (7)$$

где

$$\nu^2 = \frac{1}{4} \{\mu^2 - 4k_0^2(n_{10}^2 - \beta^2)\}, \quad (8)$$

$$q^2 = k_0^2 (\beta^2 - n_{20}^2). \quad (9)$$

Подстановка решений (6) и (7) в граничные условия (4) и (5) приводит к выражениям для параметров поля в фоторефрактивном кристалле

$$A = \frac{q}{\nu \sqrt{2g} \text{ch } qx_0} \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} q \text{th } qx_0 + \frac{\mu}{2} + \nu \right), \quad (10)$$

$$B = -\frac{q}{\nu \sqrt{2g} \text{ch } qx_0} \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} q \text{th } qx_0 + \frac{\mu}{2} - \nu \right). \quad (11)$$

Нелинейная поверхностная волна с неосциллирующим профилем (6) может затухать в глубину фоторефрактивного кристалла немонотонно или монотонно. Монотонное затухание волны в глубь фоторефрактивного кристалла может происходить в двух случаях:

- 1)  $A = 0$  и тогда  $H_0 = B$  или
- 2)  $B = 0$  и тогда  $H_0 = A$ .

Тогда из (10) и (11) получается

$$v = \mp \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} q \operatorname{th} qx_0 + \frac{\mu}{2} \right), \quad (12)$$

где выбирается знак „-“ для  $A = 0$  и „+“ для  $B = 0$ . В этих случаях распределение поля (6) в монотонной затухающей поверхностной волне в фоторефрактивном кристалле принимает вид

$$H_1(x) = H_0 e^{-\gamma x},$$

где амплитуда поля на границе раздела

$$H_0 = \sqrt{2}q/\sqrt{g} \operatorname{ch} qx_0, \quad (13)$$

коэффициент затухания

$$\gamma = -\varepsilon_1 q \operatorname{th} qx_0/\varepsilon_2.$$

Для положительности коэффициента затухания в монотонной убывающей волне должно быть  $x_0 < 0$ . Такая монотонно убывающая волна существует при фиксированной связи константы распространения, коэффициентов преломления и других физических характеристик фоторефрактивного и керровского кристаллов, определяемой выражением (12).

В отличие от такой монотонной убывающей поверхностной волны, поверхностная волна, в котором поле в фоторефрактивном кристалле описывается выражением (6), может иметь экстремум на расстоянии  $x_m = v^{-1} \ln I$ , где

$$I = \frac{(v + \mu)(v - \mu/2 - (\varepsilon_1/\varepsilon_2)g \operatorname{th} qx_0)}{(v - \mu)(v + \mu/2 + (\varepsilon_1/\varepsilon_2)g \operatorname{th} qx_0)}.$$

Экстремальное значение амплитуды поля, достигаемое на расстоянии  $x_m$  от границы раздела в глубину фоторефрактивного кристалла, можно оценить по формуле

$$H_m = \frac{qI^{-(v+\mu/2)}}{v\sqrt{2}g \operatorname{ch} qx_0} \left( \frac{2\varepsilon_1 q(v^2 + \mu^2/4) \operatorname{th} qx_0}{\varepsilon_2(v^2 - \mu^2/4)} - \mu \right).$$

### 3.2. Затухающие с осцилляциями волны

Если теперь считать, что  $n_{20} < \beta < \sqrt{n_{10}^2 - \mu^2/4k_0^2}$ , то при  $g > 0$  решение уравнения (3) остается в виде (7), а решение уравнения (2) примет вид

$$H_1(x) = H_0 e^{-\mu x/2} \cos(px + \varphi)/\cos \varphi, \quad (14)$$

$$p^2 = -v^2 = \frac{1}{4} \{4k_0^2(n_{10}^2 - \beta^2) - \mu^2\}. \quad (15)$$

Распределение поля (14) в поверхностной волне затухает с осцилляциями при удалении от границы раздела в глубину фоторефрактивного кристалла. Характерный период осцилляций поля:  $\Lambda = 2\pi/p$ , глубина проникновения в фоторефрактивный кристалл:  $l = 2/\mu$ . Затухание поля в глубину керровского кристалла по-прежнему происходит без осцилляций.

Подстановка решений (7) и (14) в граничные условия (4) и (5) приводит к амплитуде поля  $H_0$  в фоторефрактивном кристалле в виде (13), а также к дисперсионному соотношению

$$p \operatorname{tg} \varphi = - \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} q \operatorname{th} qx_0 + \frac{\mu}{2} \right). \quad (16)$$

Дисперсионное соотношение (16), определяющее зависимость константы распространения от коэффициентов преломления и других физических характеристик фоторефрактивного и керровского кристаллов, можно проанализировать в различных предельных случаях.

В частности, при  $\varphi = 0$  и  $qx_0 \ll 1$  из (16) можно получить в явном виде закон дисперсии

$$\beta^2(x_0) = n_{20}^2 - \frac{\mu\varepsilon_2}{2\varepsilon_1 x_0 k_0^2}. \quad (17)$$

Волна с законом дисперсии (17) существует при  $x_0 < 0$ .

При  $x_0 = 0$  и меняющемся  $\varphi$  из (16) получается закон дисперсии в виде

$$\beta^2(\varphi) = n_{10}^2 - \frac{\mu^2}{4k_0^2} (1 + \operatorname{ctg}^2 \varphi). \quad (19)$$

Условие существования такой волны с законом дисперсии (18) определяются неравенством:  $\operatorname{ctg}^2 \varphi < 4k_0^2 n_{10}^2/\mu^2 - 1$ .

При  $qx_0 \ll 1$  и меняющемся  $\varphi$  из (16) получается закон дисперсии в виде

$$\beta^2(\varphi) = n_{10}^2 - \frac{\mu^2}{4k_0^2} - \left( \frac{\varepsilon_2 \operatorname{tg} \varphi}{2\varepsilon_1 k_0 x_0} \right)^2 \{1 \pm D^{1/2}\}, \quad (20)$$

$$D = 1 - f \operatorname{ctg}^2 \varphi,$$

$$f = \frac{4\varepsilon_1 x_0}{\varepsilon_2} \left\{ \frac{\varepsilon_1 x_0}{\varepsilon_2} \left[ \frac{\mu^2}{4} - k_0^2 (n_{10}^2 - n_{20}^2) \right] - \frac{\mu}{2} \right\}.$$

Условие существования такой волны с законом дисперсии (20) определяются неравенством:  $\operatorname{tg}^2 \varphi > f$ .

При меняющемся  $\varphi$  в основном приближении константа распространения зависит от квадрата коэффициента затухания волны в фоторефрактивном кристалле. От коэффициента керровской нелинейности зависит только амплитуда поверхностной волны.

#### 4. Зависимость константы распространения от амплитуды поля

В теории нелинейных колебаний часто такие характеристики как, например, частота, выражаются через амплитуду. Для нелинейных поверхностных волн имеет смысл проанализировать зависимость частоты константы распространения от амплитуды поля на границе раздела кристаллов. В п. 3 проведен анализ поведения константы распространения от свободного (управляющего) параметра  $x_0$ , характеризующего положение „центра солитона“ в керровском кристалле. Далее в качестве управляющего параметра выберем величину  $H_0$ , определяемую выражением (13). В результате удастся найти точные решения дисперсионных уравнений в явном аналитическом виде.

##### 4.1. Зависимость константы распространения от амплитуды монотонно затухающих волн

Если исключить из (12)  $x_0$  с помощью (13), то получится дисперсионное уравнение

$$v = \mp \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sqrt{q^2 - \frac{gH_0^2}{2}} + \frac{\mu}{2} \right), \quad (21)$$

точное решение которого позволяет при использовании (8) и (9) получить зависимость константы распространения от амплитуды в виде

$$\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + \frac{1}{2\delta\varepsilon^2 k_0^2} \left\{ \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 - 2\delta\varepsilon d_0 \pm D_0^{1/2} \right\}, \quad (22)$$

$$\delta\varepsilon = 1 - \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2, \quad d_0 = \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \frac{gH_0^2}{2} - k_0^2(n_{10}^2 - n_{20}^2),$$

$$D_0 = \left\{ \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 - 2\delta\varepsilon d_0 \right\}^2 - 4\delta\varepsilon^2 \left\{ d_0^2 + \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \frac{gH_0^2}{2} \right\}.$$

Из (22) следует, что в случае малоамплитудных колебаний в основном приближении квадрат константы распространения зависит линейно от квадрата амплитуды:  $\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + aH_0^2$ , где  $a$  определяется параметрами кристаллов и не зависит от амплитуды  $H_0$ .

Если амплитуда на границе раздела кристаллов связана с оптическими характеристиками кристаллов специальным соотношением (получаемым из условия  $(\mu\varepsilon_1/\varepsilon_2)^2 = 2\delta\varepsilon d_0$ ):

$$H_0^2 = \frac{1}{g} \left\{ \frac{\mu^2}{\delta\varepsilon} + 2k_0^2(n_{10}^2 - n_{20}^2) \left( \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right)^2 \right\}, \quad (23)$$

то из (22) следует зависимость константы распространения поверхностной волны

$$\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + \frac{1}{k_0^2} \left\{ -\frac{1}{\delta\varepsilon} \left[ \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \frac{gH_0^2}{2} + \left( \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \frac{gH_0^2}{2} - k_0^2(n_{10}^2 - n_{20}^2) \right)^2 \right] \right\}^{1/2}, \quad (24)$$

куда подставляется (23). Для существования такой поверхностной волны достаточно того, чтобы линейный показатель преломления фоторефрактивного кристалла был больше линейного показателя преломления керровского кристалла.

В случае малости  $\delta\varepsilon \ll 1$ , что соответствует тому, что значения линейных показателей преломления фоторефрактивного керровского кристаллов близки, из (21) можно получить константу распространения в виде

$$\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + \frac{1}{k_0^2} \times \left\{ \frac{gH_0^2}{2} + \left( \frac{\varepsilon_2}{\mu\varepsilon_1} \right) \left( \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \frac{gH_0^2}{2} - k_0^2(n_{10}^2 - n_{20}^2) \right)^2 \right\}. \quad (25)$$

Если линейный показатель преломления фоторефрактивного кристалла много больше линейного показателя преломления керровского кристалла, из (21) можно получить константу распространения в виде

$$\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + \frac{gH_0^2}{2k_0^2}. \quad (26)$$

В таком предельном случае ( $n_{20} \ll n_{10}$ ) значение константы распространения при малых амплитудах близко к линейному показателю преломления керровского кристалла, а ее квадрат линейно зависит от квадрата амплитуды поля на границе раздела кристаллов.

Следует отметить, что зависимости (25) и (26) являются приближенными решениями дисперсионного уравнения (21) в отличие от зависимости (22) и ее частных случаев (23) и (24), которые являются точными решениями дисперсионного уравнения (21).

##### 4.2. Зависимость константы распространения от амплитуды затухающих с осцилляциями волн

Если исключить  $x_0$  из (16) с помощью (13), то получится дисперсионное уравнение

$$p \operatorname{tg} \varphi = - \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sqrt{q^2 - \frac{gH_0^2}{2}} + \frac{\mu}{2} \right), \quad (27)$$

точное решение которого позволяет при использовании (9) и (15) получить зависимость константы распространения от амплитуды при меняющемся  $\varphi$  в виде

$$\beta^2(H_0, \varphi) = n_{10}^2 - \frac{1}{2\delta\varepsilon_\varphi k_0^2} \left\{ \delta\varepsilon_\varphi d_\varphi - \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \pm D_\varphi^{1/2} \right\}, \quad (28)$$

$$\delta\varepsilon_\varphi = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} + \text{tg}^2 \varphi,$$

$$b_\varphi = \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right) \left\{ k_0^2 (n_{10}^2 - n_{20}^2) - \frac{gH_0^2}{2} \right\},$$

$$d_\varphi = \frac{\mu^2}{4} (1 + \text{tg}^2 \varphi) + b_\varphi,$$

$$D_\varphi = \left\{ \delta\varepsilon_\varphi d_\varphi - \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \right\}^2 - 4\delta\varepsilon_\varphi^2 \left\{ d_\varphi^2 \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 b_\varphi \right\},$$

При  $\varphi = 0$  из (28) можно получить закон дисперсии в виде

$$\beta^2(H_0) = n_{20}^2 + \frac{1}{k_0^2} \left\{ \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{2\varepsilon_2} \right)^2 + \frac{gH_0^2}{2} \right\}, \quad (29)$$

который представляет собой линейную зависимость от квадрата амплитуды поля. Из (28) также следует, что  $\text{tg} \varphi < 0$ .

Если амплитуда на границе раздела кристаллов связана с оптическими характеристиками кристаллов специальным соотношением (получаемым из условия  $(\mu\varepsilon_1/\varepsilon_2)^2 = 2\delta\varepsilon_\varphi d_\varphi$ ):

$$H_0^2 = \frac{2}{g} \left\{ \frac{\mu^2 \varepsilon_2}{2\varepsilon_1} \left( 1 + \text{tg}^2 \varphi - \frac{2}{a_\varphi} \right) + k_0^2 (n_{10}^2 - n_{20}^2) \right\}, \quad (30)$$

то из (27) следует зависимость константы распространения поверхностной волны

$$\beta^2(H_0, \varphi) = n_{10}^2 - \frac{1}{\delta\varepsilon_\varphi k_0^2} \left\{ \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 b_\varphi - d_\varphi^2 \right\}^{1/2}, \quad (31)$$

куда подставляется (30). Для существования такой поверхностной волны должно выполняться условие  $(\mu\varepsilon_1/\varepsilon_2)^2 b_\varphi > d_\varphi^2$ .

Если амплитуда на границе раздела кристаллов связана с оптическими характеристиками кристаллов специальным соотношением (получаемым из условия  $(\mu\varepsilon_1/\varepsilon_2)^2 b_\varphi = d_\varphi^2$ ):

$$H_0^2 = \frac{2}{g} \left\{ \frac{\mu^2}{2} \left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_2}{2\varepsilon_1} (1 + \text{tg}^2 \varphi) \right) + k_0^2 (n_{10}^2 - n_{20}^2) \pm \sqrt{\left( \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 - (1 + \text{tg}^2 \varphi)} \right\}, \quad (32)$$

то из (28) следует зависимость константы распространения поверхностной волны

$$\beta^2(H_0, \varphi) = n_{10}^2 - \frac{1}{k_0^2} \left\{ a_\varphi d_\varphi - \left( \frac{\mu\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right)^2 \right\}, \quad (33)$$

куда подставляется (32). Для существования такой поверхностной волны значения  $\varphi$  выбираются из условий:  $(\mu\varepsilon_1/\varepsilon_2)^2 < a_\varphi d_\varphi$  и  $\cos \varphi > \varepsilon_2/\varepsilon_1$ .

### 5. Заключение

Таким образом, в данной работе установлено, что на границе раздела фоторефрактивного кристалла и керровского кристалла с фокусирующей нелинейностью могут существовать нелинейные поверхностные волны несимметричного профиля двух типов. Волны первого типа затухают при удалении от границы раздела без осцилляций как в глубину фоторефрактивного кристалла, так и керровского, а волны второго типа затухают в глубину фоторефрактивного кристалла с осцилляциями. Волны первого типа могут затухать монотонно при определенных условиях связи константы распространения, коэффициентов преломления и других физических характеристик фоторефрактивного и керровского кристаллов.

Возможность существования волн с осциллирующим затуханием при определенных условиях принципиально отличает контакт фоторефрактивного кристалла с фокусирующей керровской средой от контакта двух нелинейных керровских сред или контакта нелинейной и линейной сред. Данное обстоятельство имеет существенное значение для проектирования различных оптических устройств (переключателей, сенсоров), использующих волноводные свойства нелинейных поверхностных волн [25–27].

### Список литературы

- [1] V. Tekkozyan, A. Babajanyan, K. Nerkararyan. *Opt Commun.* **305**, 190 (2013).
- [2] Y.V. Bludov, D.A. Smirnova, Yu.S. Kivshar, N.M.R. Peres, M.I. Vasilevsky. *Phys. Rev. B* **89**, 035406 (2014).
- [3] I.S. Panyaev, D.G. Sannikov. *J. Opt. Soc. Am. B.* **33**, 220 (2016).
- [4] A.I. Ignatov, I.A. Nechepurenko, D.G. Baranov. *Ann. Phys.* **528**, 537 (2016).
- [5] D. Yang, Tian H. *J. Opt.* **18**, 1 (2016).
- [6] F.I. Haddouche, L. Cherbi. *Opt. Commun.* **382**, 132 (2017).
- [7] Y.M. Aleksandrov, V.V. Yatsishen. *J. Nano- and Electronic Phys.* **9**, 03039 (2017).
- [8] В.Н. Белый, Н.А. Хило. *Письма в ЖТФ* **23**, 31 (1997).
- [9] Д.Х. Усевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева, П.А. Лыков, Н.В. Богодаев. *Квантовая электрон.* **40**, 437 (2010).
- [10] Д.Х. Усевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. *Квантовая электрон.* **43**, 14 (2013).

- [11] С.А. Четкин, И.М. Ахмеджанов. Квантовая электрон. **41**, 980 (2011).
- [12] Yu.S. Kivshar, G.P. Agrawal. Optical Solitons: From Fibers to Photonic Crystals, Academic Press, San Diego (2003). 540 p.
- [13] Yu.S. Kivshar, A.M. Kosevich, O.A. Chubykalo. Phys. Rev. A **41**, 1677 (1990).
- [14] F.Kh. Abdullaev, B.B. Baizakov, B.A. Umarov. Opt. Commun. **156**, 341 (1998).
- [15] A.A. Sukhorukov, Yu.S. Kivshar. Phys. Rev. Lett. **87**, 083901 (2001).
- [16] С.Е. Савотченко. Изв. вузов. Физика **47**, 79 (2004).
- [17] S.E. Savotchenko. Mod. Phys. Lett. B **32**, 1850120 (2018).
- [18] С.Е. Савотченко. ЖЭТФ **154**, 514 (2018).
- [19] N.N. Ahmediev, V.I. Korneev, U.V. Kuzmenko. JETP **88**, 107 (1985).
- [20] С.Е. Савотченко. Конденсированные среды и межфазные границы **19**, 567 (2017).
- [21] С.Е. Савотченко. Вестн. ВГУ. Сер.: Физика. Математика **1**, 44 (2018).
- [22] S.E. Savotchenko. Surfaces Interfaces **13**, 157 (2018).
- [23] М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике, Наука, Спб. (1992). 320 с.
- [24] V.S. Zuev, J. Russ. Laser Res. **26**, 347 (2005).
- [25] N. Zhong, Z. Wang, M. Chen, X. Xin, R. Wu, Y. Cen, Y. Li. Sensors Actuators B **254**, 133 (2018).
- [26] D. Zhang, Z. Li, W. Hu, B. Cheng. Appl. Phys. Lett. **67**, 2431 (1995).
- [27] T. Strudley, R. Bruck, B. Mills, O.L. Muskens. Light: Science & Applications **3**, e207 (2014).

*Редактор Т.Н. Василевская*